



F 139 B
(CB 76)



TO 18
(CB 6)

Silicon PNP transistors, general purpose (continued)
Transistors PNP silicium, usage général (suite)

T_{amb} = 25 °C

Type	Case <i>Boîtier</i>	P _{tot} (mW)	V _{CEO} (V)	h _{21E}		I _C (mA)	V _{CEsat} (V)	I _C /I _B (mA)	f _T (MHz)	t _s (ns)	TSi 76 Page
			V _{CEr} * V _{CEX} □	min	max					t _{off} *	
BCW 97 A	F 139 B○	540	-60	100	200	-50	-0,25	50/5	135		445
BCW 97 B	F 139 B○	540	-60	150	300	-50	-0,25	50/5	135		445
BCY 78 VII	TO 18	390	-32	120	220	-2	-0,25	10/0,25			465
BCY 78 VIII	TO 18	390	-32	180	310	-2	-0,25	10/0,25			465
BCY 78 IX	TO 18	390	-32	250	460	-2	-0,25	10/0,25			465
BCY 78 X	TO 18	390	-32	380	630	-2	-0,25	10/0,25			465
BCY 79 VII	TO 18	390	-45	120	220	-2	-0,8	100/2,5			465
BCY 79 VIII	TO 18	390	-45	180	310	-2	-0,8	100/2,5			465
BCY 79 IX	TO 18	390	-45	250	460	-2	-0,8	100/2,5			465
BCY 79 X	TO 18	390	-45	380	630	-2	-0,8	100/2,5			465
BSV 15	TO 39	3200 ¹	-40	40	250	-100	-1	500/25	50	500	703
BSV 16	TO 39	3200 ²	-60	40	250	-100	-1	500/25	50	500	703
BSW 21	TO 18	300	-25	75	225	-2	-0,5	50/3	150	200§	709
BSW 21 A	TO 18	300	-50	75	225	-2	-0,5	50/3	150	200§	709
BSW 22	TO 18	300	-25	180	540	-2	-0,5	50/3	150	200§	709
BSW 22 A	TO 18	300	-50	180	540	-2	-0,5	50/3	150	200§	709

Silicon NPN transistors, low noise, low level amplification

Transistors NPN silicium, amplification faible bruit, faible niveau

T_{amb} = 25 °C

Type	Case <i>Boîtier</i>	P _{tot} (mW)	V _{CEO} (V)	h _{21E}		I _C (mA)	V _{CEsat} (V)	I _C /I _B (mA)	f _T (MHz)	F (dB)	TSi 76 Page
				min	max					max	
2N 929	TO 18	300	45	40	120	0,01	1	10/0,5	30	4	125
*2N 930	TO 18	300	45	100	500	0,01	1	10/0,5	30	3	125
2N 2483	TO 18	360	60	40	120	0,01	0,35	1/0,1	60	4	201
*2N 2484	TO 18	360	60	100	500	0,01	0,35	1/0,1	60	3	201
BCY 69	TO 18	300	20	600*	900*	2	0,25	10/0,5	150	5	459

* Preferred device

Dispositif recommandé

§ Typical value

Valeur typique

□ Plastic case

Boîtier plastique

¹ T_{case} = 60 °C V_{CE} ≤ 6 V

² T_{case} = 60 °C V_{CE} ≤ 7 V